毎日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭60-195957

@Int,Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28 7357-5F 7738-5F

客査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

リードフレーム

②特 顧 昭59-50939

公出 顧 昭59(1984)3月19日

砂発明 者 谷川

商 太

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

砂発 明 者 中

洋

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

切出 顧 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

の代理人 弁理士 高橋 明夫 外1名

沢

m · m 4

発明の名称 リードフレーム

特許請求の範囲

1. 側面に突出部を設けて成ることを特象とする リードフレーム。

2. 前記リードフレームがプラステックモールド 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

[技術分野]

本発明はリードフレームに関し、特に、モールドレジンとの倍着性を良くし、対止性のよい樹脂 対止型半導体製量を得ることができるリードフレ ームに関する。

〔智景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1回に 示すごときものが周知である(工業調査会刊「IC 化実装技術」 P137~P150 など)。第1回に て、1は半導体テップをマウントするタブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導 体チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード側の電極及 び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ポンディング法などによりポン ディングして電気的袋繞を行った後に、樹脂(レ ジン)を周知のトランスフェーモールド法などに より半導体チップやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂對止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂割止型半導体装置にあっては、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、剣止性(耐運性)を向上させ、信頼度を向上させることが必要であり、近時は半導体チップの大形化に伴ない、剣止巾が増々狭くなっており、これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装置に使用されるリードフレームにあっては、その質面がフラットに構成されており、リードフレームとレジンとの密着性が不足し、對止性、信頼度の向上という面で問題があることがわかった。

(発明の目的)

本発明はリードフレームとレジンとの密層(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、対止性を向上し、信頼度の高い樹脂対止数半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前配ならびにそのほかの目的と新規な 特数は、本明細書の配送および続付図面からあき らかになるであろう。

[発明の氨要]

本 駅 において 関示される 発明のうち代表的なものの 概要を 簡単に 説明すれば、 下配のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 飲付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リ ードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リ ードフレーム表面積増大によるリータパスの伴長 をはかって外部からの復気等の表透性異物の侵入 の半導体チェブへの到連時間を長くして、剣止性 を向上させ、製品券命を延命し、信頼性を向上させることに成功した。

[疾始伤]

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2回は本発明リードフレームの要部針視回、 第3回は第2回I-I線所面回を示す。

これら図において、4は半導体チップを搭載するためのタップの上に化少要な樹脂穴である。本発明り、5はタブ吊りリード、6はリード、7は樹脂穴である。本発明では、本発明では、これら図にの示するように、タブイトのように、タブイトのように、タブイトのように、タブイトの表を設けて成る。この突出部8の形成は、例えば、通常の方法により側面がファスを設けてより作用にあるように形成してもよいの突出するように形成してもよいので、アングにより周端最から通宜幅を上下からで、アングにより周端最から通宜幅を上下がら突出するように形成してもよいの他通宜の戻さでエッチング除去することにより形成してもよく、その他通宜の方法が採用できる。

第4 図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂封止型半導体整置の断面図を示し、第4回に て、9は半導体チャブ、10はコネクタワイヤ。 11は樹脂封止体、12はリードフレームで半導 体チャブ9を搭載しているタブ13、及び半導体 チャブ9の内部配数をコネクタワイヤ10を用い て外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部 15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン単縮晶基板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の国路票子が形成され、1つの国路機能を与えている。国路票子は例えば、絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの国路票子によって、例えば論理回路およびメモリの国路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム(A8)細胞により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエポキン樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5回は本発明の他の 実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の関係で横方向に 複数の線系の構部16を設けて成る実施例を示す。 近時、第4図に示すような機器封止型半導体装置 において、半導体チャブ9が大形化し、リード14 の機器対止体11に担込まれる長さが次第に短く なってきている。そうすがあげリードとする場合、 げて第4図に示すような折曲げリードとする場合、 折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンから スリップし、リードが機踏対止体外部によけいに 引っぱり出されることになる。かかる講部16を 設けることにより、より一層、リードフレームと レジンとの密着性を向上し得る。

〔劝 录〕

- (1) リードフレームの切断面に設付けを行ない、 側面に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、 リードフレームとレジンの密着性の向上が図られ る。
- (2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

かつ、毎節がフラットである場合に比較して、段 が形成されているのでリータパスが長くなり、そ の結果外部からの半導体装置内部への長遠性異物 の侵入が避くなり封止性(耐健性)が向上する。 (3) リードフレームとレジンとの密着性。 対止性 の向上により製品寿命を延命し、樹脂樹止理半導 体製量の信頼性を着しく向上することができる。 (4) 半導体チップが大変化し、リードのモールド レジン中へ組め込まれている部分が増々無くなっ ている今日、リードフレームに良付けを行い、リ ードフレームとレジンとの密着性の向上の殴り、 對止性を向上し、半導体装置の名類性を向上し得 ることは工業上価めて有意義である。

(5) リードフレームの側面に突出部を設けること に加えて、第5回に示すように、リードの上面に 講部を形成することにより、より一層 リードフレ ームとレジンとの密着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に際し、リードがゆるん だり、樹脂封止体の外部に突出したりすることを 防止できる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に もとづき具体的に説明したが、本発明は上配実施 例に限定されるものではなく、その甚旨は途脱し ない範囲で種々変更可能であることはいうまでも たい。

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面 全体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出 部を設けても差支えない。又前記実施例では講部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。 [利用分野]

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパ ッケージの他、フラットパッタタイプのパッケージ など他の複数対止選半導体装置にも適用すること ができ、樹脂對止型半導体製置全般に適用できる。 又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。 図面の簡単な説明

第1回はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2回は本発明リードフレームの要部所視回、 第3回は第2回I~I隷断面図、

第4回は本発明リードフレームを使用して成る 樹田製止型半導体装置の断面配、

第 5 図は本発明の他の実施例を示すリードフレ

ームの平面図である。

1…タブ、2…タブ吊りリード、3…リード、 4…タブ、5…タブ品がリード、6…リード、7

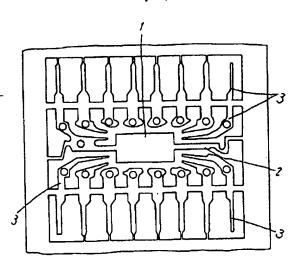
…樹脂穴、8 …英出幕、9 …半導体デッツ、1 0 …コネクタワイヤ、11…樹樹對止体、12… yladfaml

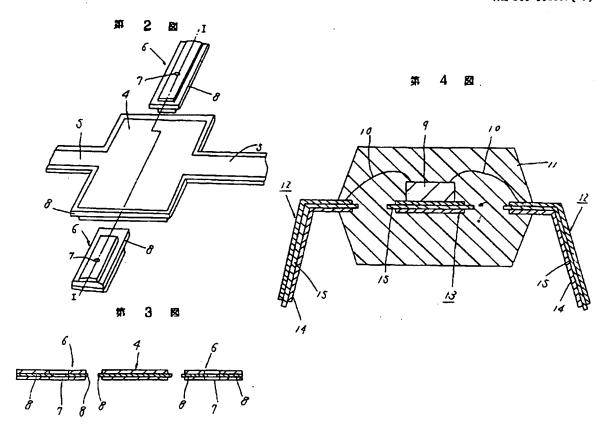
ードフレーム、18…メブ、14…リード、15

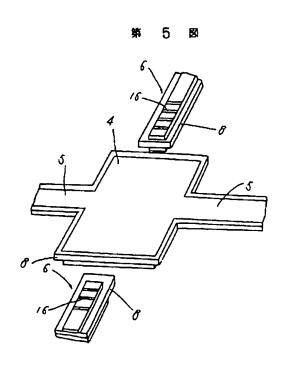
…突出部、16…清部。

4577,151

代理人 弁理士







Abstract of Japanese Patent Office Gazette

No. H6-140563

SEMICONDUCTOR DEVICE

Inventor:

Tsuji Masahiro

Applicant:

Rohm Co., Ltd.

Filed:

Oct. 23, 1992

Disclosed:

May 20, 1994

PURPOSE: To provide a semiconductor device prevented from generating the exfoliations of a resin from a die pad in a chain-reacting way and from generating the cracks of the resin, by improving the adhesiveness of the resin to the die pad in the corner of the die pad wherein the exfoliations are especially apt to occur, in the resin-sealed semiconductor device including a semiconductor chip die-bonded to the die pad.

CONSTITUTION: On each sidewall of a die pad 1, a recessed part 11 or a protruding part or the combination thereof is formed. Then, a resin 6 is made to eat into the recessed part 11 or to cover completely the protruding part, and concurrently, the effect of the difference between the thermal expansion coefficients of the resin 6 and the die pad 1 is made small by covering thin protruding parts 12 of the die pad 1 with the resin 6. Thereby, the adhesiveness of the resin 6 to the die pad 1 is improved.